

Układ UL 1000 zawiera dwa tranzystory połączone w układzie przydatnym w konstrukcjach modulatorów kołowych. Wymaga zastosowania dwóch transformatorów równoważących. Układ przeznaczony jest do zastosowania w układach teletechnicznych.

UL 1000L
ULA 1000L

Modulator (demodulator)
kołowy

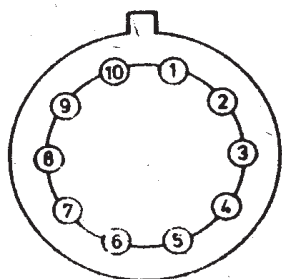
Obudowa CE 52

Parametry dopuszczalne

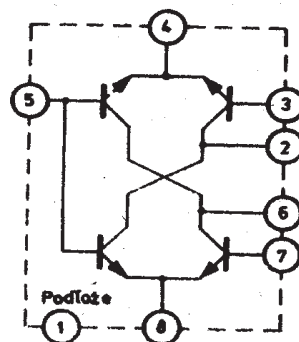
/ $t_{amb} = +25^{\circ}\text{C}$ /

Oznaczenie	Nazwa	Jedn.	Wartość	
			min	max
U_{CB}	Napięcie stałe kolektor-baza	V		10
U_{EB}	Napięcie stałe emiter-baza	V		5
U_{CS}	Napięcie stałe kolektor-podłoże	V		12
I_C	Prąd stały kolektora /jednego tranzystora/	mA		10
P_c	Moc tracona w całym układzie /przy $t_{amb} = 100^{\circ}\text{C}$ /	mW		100
t_{amb}	Zakres temperatur pracy	$^{\circ}\text{C}$	-25	+100
			-40	+100
t_{stg}	Zakres temperatur przechowywania	$^{\circ}\text{C}$	-40	+125
			-55	+125

Układ wyprowadzeń



Widok od spodu



Schemat wewnętrzny

Parametry charakterystyczne

$t_{amb} = +25^{\circ}C/$

Oznaczenie	Nazwa	Jedn.	Wartość			Warunki pomiaru Uwagi
			min	typ	max	
I_{CBO}	Prąd zerowy kolektora	nA		5	100	$U_{CB}=5\text{ V}; I_E=0\text{ A}$
I_{EBO}	Prąd zerowy emitera	nA		5	100	$U_{EB}=1\text{ V}; I_C=0\text{ A}$
I_{CS}	Prąd zerowy kolektor- -podłoże	nA		5	100	$U_{CS}=9,5\text{ V}$
$U_{BR/CBO}$	Napięcie przebicia kolektor-baza	V	10	35		$I_C=10\text{ }\mu\text{A}; I_E=0\text{ A}$
$U_{BR/EBO}$	Napięcie przebicia emiter-baza	V	5	7		$I_E=200\text{ }\mu\text{A}; I_C=0\text{ A}$
$U_{BR/CEO}$	Napięcie przebicia kolektor-emiter	V	9	13		$I_C=10\text{ }\mu\text{A}; I_B=0\text{ A}$
$U_{BR/CS}$	Napięcie przebicia kolektor-podłoże	V	12	36		$-I_{CS}=10\text{ }\mu\text{A}; I_E=0\text{ A}$ $I_B=0\text{ A}$
h_{21E}	Statyczna wartość współ- -czynnika wzmocnienia prądowego /w układzie wspólnego emitera/		20	75		$U_{CE}=5\text{ V}; I_C=150\text{ }\mu\text{A}$
$ U_{BE1}-U_{BE2} $	Różnica napięć stałych między bazą a emiterem tranzystorów T_1 i T_2	mV		2	5	$-I_{E1}=-I_{E2}=150\text{ }\mu\text{A}$ $U_{CB1}=U_{CB2}=5\text{ V}$
$ U_{BE3}-U_{BE4} $	Różnica napięć stałych między bazą a emiterem tranzystorów T_3 i T_4	mV		2	5	$-I_{E3}=-I_{E4}=150\text{ }\mu\text{A}$ $U_{CB3}=U_{CB4}=5\text{ V}$
$ h_{21B1}-h_{21B2} $	Różnica statycznych war- -tości współczynników wzmocnienia prądowego tranzystorów T_1 i T_2 /w układzie wspólnej bazy/			0,002	0,008	$I_{E1}=-I_{E2}=150\text{ }\mu\text{A}$ $U_{CB1}=U_{CB2}=5\text{ V}$
$ h_{21B3}-h_{21B4} $	Różnica statycznych war- -tości współczynników wzmocnienia prądowego tranzystorów T_3 i T_4 /w układzie wspólnej bazy/			0,002	0,008	$-I_{E3}=-I_{E4}=150\text{ }\mu\text{A}$ $U_{CB3}=U_{CB4}=5\text{ V}$
F	Współczynnik szumów	dB		6		$f_p=1\text{ kHz}; -I_E=150\text{ }\mu\text{A}$ $U_{CB}=5\text{ V}; R_g=1\text{ k}\Omega$ $B=200\text{ Hz}$